

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»  
(ТУСУР)



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 1с6сfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820

Владелец: Троян Павел Ефимович

Действителен: с 19.01.2016 по 16.09.2019

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**Физика фотонных кристаллов**

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**

Направление подготовки (специальность): **12.03.03 Фотоника и оптоинформатика**

Направленность (профиль): **Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФЭТ, Факультет электронной техники**

Кафедра: **ЭП, Кафедра электронных приборов**

Курс: **4**

Семестр: **8**

Учебный план набора 2016 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	8 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	16	16	часов
2	Практические занятия	24	24	часов
3	Всего аудиторных занятий	40	40	часов
4	Из них в интерактивной форме	30	30	часов
5	Самостоятельная работа	32	32	часов
6	Всего (без экзамена)	72	72	часов
7	Общая трудоемкость	72	72	часов
		2.0	2.0	З.Е

Зачет: 8 семестр

Томск 2017

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика, утвержденного 03 сентября 2015 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_.

Разработчики:

ст. преподаватель каф. ЭП \_\_\_\_\_ В. В. Щербина

Заведующий обеспечивающей каф.  
ЭП

\_\_\_\_\_ С. М. Шандаров

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами направления подготовки (специальности).

Декан ФЭТ \_\_\_\_\_ А. И. Воронин

Заведующий выпускающей каф.  
ЭП

\_\_\_\_\_ С. М. Шандаров

Эксперты:

председатель методической комиссии кафедры ЭП, профессор каф.  
ЭП кафедра ЭП

\_\_\_\_\_ Л. Н. Орликов

## 1. Цели и задачи дисциплины

### 1.1. Цели дисциплины

освоение студентами теоретических основ строения таких твердотельных материалов, как фотонные кристаллы, изучение их свойств, процессов и эффектов в них происходящих.

### 1.2. Задачи дисциплины

- заключаются в изучении основ строения фотонных кристаллов;
- изучении основных характеристик и свойств фотонных кристаллов;
- изучении основных процессов и эффектов, происходящие в фотонных кристаллах;
- применения фотонных кристаллов в современных приборах и устройствах фотоники и оптоинформатики.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физика фотонных кристаллов» (Б1.В.ОД.10) относится к блоку 1 (вариативная часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются следующие дисциплины: Взаимодействие оптического излучения с веществом, Голографические методы в фотонике и оптоинформатике, Когерентная оптика и голография, Материалы нелинейной оптики.

## 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-2 готовностью к математическому моделированию процессов и объектов фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов;
- ПК-3 способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике;

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **знать** фундаментальные физические закономерности, определяющие свойства кристаллических и некристаллических материалов; методы обработки и анализа информации в уравнениях с частными производными применительно к фотонным кристаллам; знать методы математического анализа поставленной задачи исследований в фотонных кристаллах
- **уметь** выполнять оценочные расчеты электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов; моделировать реальные процессы как краевые задачи для уравнений в частных производных применительно к фотонным кристаллам; уметь писать макросы для самостоятельно разработанных программных продуктов
- **владеть** навыками анализа научно-технической литературы, навыками расчета электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов; методами решения уравнений в частных производных для теоретических и практических задач с использованием информационных, компьютерных технологий; владеть стандартными пакетами автоматизированного проектирования

## 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры
		8 семестр
Аудиторные занятия (всего)	40	40
Лекции	16	16
Практические занятия	24	24
Из них в интерактивной форме	30	30
Самостоятельная работа (всего)	32	32

Проработка лекционного материала	8	8
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	24	24
Всего (без экзамена)	72	72
Общая трудоемкость ч	72	72
Зачетные Единицы	2.0	2.0

## 5. Содержание дисциплины

### 5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
8 семестр					
1 Фотонные кристаллы. Эффекты в фотонных кристаллах	4	6	8	18	ПК-2
2 Нелинейно-оптические явления в фотонных кристаллах	4	6	8	18	ПК-2, ПК-3
3 Методы изготовления фотонных кристаллов различных размерностей.	4	6	8	18	ПК-2, ПК-3
4 Применение фотонных кристаллов.	4	6	8	18	ПК-2, ПК-3
Итого за семестр	16	24	32	72	
Итого	16	24	32	72	

### 5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины по лекциям	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
8 семестр			
1 Фотонные кристаллы. Эффекты в фотонных кристаллах	Методы описания зонной структуры фотонных кристаллов. Методы расчета фотонной запрещенной зоны одномерных, двумерных и трехмерных фотонных кристаллов. Общая формулировка в рамках формализма функций Грина. Расчет зонной структуры трехмерных фотонных кристаллов.. Задача о трехмерной дифракции в фотонных кри-	4	ПК-2

	сталлах. Методы расчета фотонной запрещенной зоны двумерных фотонных кристаллов. Метод конечных разностей, метод разложения по плоским волнам. Расчет зонной структуры одномерных фотонных кристаллов. Оптические и магнитооптические эффекты в фотонных кристаллах.		
	Итого	4	
2 Нелинейно-оптические явления в фотонных кристаллах	Методы описания нелинейно-оптического отклика фотонных кристаллов и нелинейного распространения света в фотонных решетках. Солитонное и волноводное распространение света в фотонных кристаллах с квадратичной и кубической восприимчивостями. Нелинейные фотонные кристаллы и оптические сверхрешетки. Понятие о нелинейных фотонных кристаллах. Двумерный фазовый синхронизм при генерации второй гармоники в нелинейных фотонных кристаллах. Нелинейно-оптические и нелинейные магнитооптические эффекты в фотонных кристаллах. Эффекты на кубической восприимчивости. Суперконтинуум и бистабильность в фотонных кристаллах.	4	ПК-2, ПК-3
	Итого	4	
3 Методы изготовления фотонных кристаллов различных размерностей.	Основные материалы для изготовления фотонных кристаллов. Примеры одномерных фотонных кристаллов. Брэгговские зеркала, микрорезонаторы, одномерные волноводы. Двумерные фотонные кристаллы. Трехмерные фотонные кристаллы. Опалы, инвертированные опалы, самоагрегирующийся латекс. Методы создания оптических сверхрешеток и нелинейных фотонных кристаллов. Периодические и квазипериодические доменные структуры. Методы создания нелинейных фотонных кристаллов.	4	ПК-2, ПК-3
	Итого	4	
4 Применение фотонных кристаллов.	Устройства оптоэлектроники на основе фотонных кристаллов. Оптические диоды и транзисторы. Дырчатые волокна. Микролазеры без инверсии населенности. Оптические переключатели и мультиплексоры. Магнитооптические модуляторы света. Электромагнитные кристаллы для ИК и СВЧ областей. Фононные кристаллы. Спиновые	4	ПК-2, ПК-3

	(магнитные) кристаллы. Плазмонные кристаллы.		
	Итого	4	
Итого за семестр		16	

### 5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин			
	1	2	3	4
Предшествующие дисциплины				
1 Взаимодействие оптического излучения с веществом	+			
2 Голографические методы в фотонике и оптоинформатике		+		
3 Когерентная оптика и голография		+		
4 Материалы нелинейной оптики				+

### 5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций и видов занятий, формируемых при изучении дисциплины

Компетенции	Виды занятий			Формы контроля
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
ПК-2	+	+	+	Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях, Выступление (доклад) на занятии
ПК-3	+	+	+	Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях

### 6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Методы	Интерактивные практические занятия	Интерактивные лекции	Всего
8 семестр			

Мозговой штурм	20		20
Презентации с использованием слайдов с обсуждением		10	10
Итого за семестр:	20	10	30
Итого	20	10	30

### 7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП

### 8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8. 1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость, ч	Формируемые компетенции
8 семестр			
1 Фотонные кристаллы. Эффекты в фотонных кристаллах	Методы расчета фотонной запрещенной зоны одномерных, двумерных и трехмерных фотонных кристаллов.	2	ПК-2
	Расчет зонной структуры одномерных фотонных кристаллов.	2	
	Расчет зонной структуры трехмерных фотонных кристаллов.	2	
	Итого	6	
2 Нелинейно-оптические явления в фотонных кристаллах	Солитонное и волноводное распространение света в фотонных кристаллах с квадратичной и кубической восприимчивостями.	2	ПК-2, ПК-3
	Двумерный фазовый синхронизм при генерации второй гармоники в нелинейных фотонных кристаллах.	2	
	Суперконтинуум и бистабильность в фотонных кристаллах.	2	
	Итого	6	
3 Методы изготовления фотонных кристаллов различных размерностей.	Методы создания оптических сверхрешетках и нелинейных фотонных кристаллов.	3	ПК-2, ПК-3
	Методы создания нелинейных фотонных кристаллов.	3	
	Итого	6	
4 Применение фотонных кристаллов.	Устройства оптоэлектроники на основе фотонных кристаллов.	3	ПК-2, ПК-3
	Фононные кристаллы.	3	
	Итого	6	
Итого за семестр		24	

## 9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
8 семестр				
1 Фотонные кристаллы. Эффекты в фотонных кристаллах	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2	ПК-2	Выступление (доклад) на занятии, Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2		
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2		
	Проработка лекционного материала	2		
	Итого	8		
2 Нелинейно-оптические явления в фотонных кристаллах	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2	ПК-3, ПК-2	Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2		
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2		
	Проработка лекционного материала	2		
	Итого	8		
3 Методы изготовления фотонных кристаллов различных размерностей.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	2	ПК-3, ПК-2	Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4		
	Проработка лекционного материала	2		
	Итого	8		
4 Применение фотонных кристаллов.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	3	ПК-2, ПК-3	Конспект самоподготовки, Опрос на занятиях
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	3		



	ским занятиям, семинарам		
	Проработка лекционного материала	2	
	Итого	8	
Итого за семестр		32	
Итого		32	

### 10. Курсовая работа (проект)

Не предусмотрено РУП

### 11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

#### 11.1. Балльные оценки для элементов контроля

Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной деятельности	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
8 семестр				
Выступление (доклад) на занятии	10	10	20	40
Конспект самоподготовки	10	10	10	30
Опрос на занятиях	10	10	10	30
Итого максимум за период	30	30	40	100
Нарастающим итогом	30	60	100	100

#### 11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.

Таблица 11. 2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ	4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ	3
< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ	2

#### 11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 11.3.

Таблица 11. 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	A (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 - 89	B (очень хорошо)
	75 - 84	C (хорошо)

	70 - 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 - 69	
	60 - 64	E (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

## 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 12.1. Основная литература

1. Шандаров С.М., Шандаров В.М., Мандель А.Е., Буримов Н.И. Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах. - Томск:ТУСУР, 2007. – 241 с. ISBN 978-5-86889-426-8. (наличие в библиотеке ТУСУР - 64 экз.)

### 12.2. Дополнительная литература

1. Байков Ю.А., Кузнецов В.М. Физика конденсированного состояния - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 294 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 45 экз.)

2. Петров М.П., Степанов С.И., Хоменко А.В. // Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике. - СПб.: Наука, 1992. - 320 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)

3. Гуртов В.А. Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие /В. А. Гуртов, Р. Н. Осауленко. - М. : Техносфера, 2007. – 518 с. - ISBN 978-5-94836-141-3 (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)

### 12.3 Учебно-методические пособия

#### 12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Физика фотонных кристаллов: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов направления "Фотоника и оптоинформатика" / Щербина В. В., Шандаров С. М. - 2014. 18 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/4090>, дата обращения: 16.03.2017.

2. Физика фотонных кристаллов : Методические указания по самостоятельной работе / Щербина В. В., Шандаров С. М. - 2012. 14 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/1107>, дата обращения: 16.03.2017.

#### 12.3.2 Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

##### Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

##### Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

##### Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

### 12.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и требуемое программное обеспечение

1. Образовательный портал университета, библиотека университета

## 13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

### 13.1. Общие требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

#### 13.1.1. Материально-техническое обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, с количеством по-

садочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются наглядные пособия в виде презентаций по лекционным разделам дисциплины.

### **13.1.2. Материально-техническое обеспечение для практических занятий**

Для проведения практических (семинарских) занятий используется учебная аудитория, расположенная по адресу 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74. Состав оборудования: Учебная мебель; Доска магнитно-маркерная -1шт. Имеется помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

### **13.1.3. Материально-техническое обеспечение для самостоятельной работы**

Для самостоятельной работы используется учебная аудитория (компьютерный класс), расположенная по адресу 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 74, 1 этаж, ауд. 111. Состав оборудования: учебная мебель; компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 4 шт.; компьютеры подключены к сети ИНТЕРНЕТ и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

## **13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При обучении студентов с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения для студентов с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При обучении студентов с **нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеомониторов для удаленного просмотра.

При обучении студентов с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

## **14. Фонд оценочных средств**

### **14.1. Основные требования к фонду оценочных средств и методические рекомендации**

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении текущей, промежуточной аттестации по дисциплине приведен в приложении к рабочей программе.

### **14.2 Требования к фонду оценочных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для студентов с инвалидностью предусмотрены дополнительные оценочные средства, перечень которых указан в таблице.

**Таблица 14 – Дополнительные средства оценивания для студентов с инвалидностью**

Категории студентов	Виды дополнительных оценочных средств	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к	Преимущественно дистанционными методами

аппарата	зачету	
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами, исходя из состояния обучающегося на момент проверки

### **14.3 Методические рекомендации по оценочным средствам для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»  
(ТУСУР)**

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
\_\_\_\_\_ П. Е. Троян  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

**Физика фотонных кристаллов**

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**

Направление подготовки (специальность): **12.03.03 Фотоника и оптоинформатика**

Направленность (профиль): **Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур**

Форма обучения: **очная**

Факультет: **ФЭТ, Факультет электронной техники**

Кафедра: **ЭП, Кафедра электронных приборов**

Курс: **4**

Семестр: **8**

Учебный план набора 2016 года

Разработчики:

– ст. преподаватель каф. ЭП В. В. Щербина

Зачет: 8 семестр

Томск 2017

## 1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины (практики) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине (практике) используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной (практикой) компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

Код	Формулировка компетенции	Этапы формирования компетенций
ПК-2	готовностью к математическому моделированию процессов и объектов фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов	Должен знать фундаментальные физические закономерности, определяющие свойства кристаллических и некристаллических материалов; методы обработки и анализа информации в уравнениях с частными производными применительно к фотонным кристаллам; знать методы математического анализа поставленной задачи исследований в фотонных кристаллах;
ПК-3	способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике	Должен уметь выполнять оценочные расчеты электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов; моделировать реальные процессы как краевые задачи для уравнений в частных производных применительно к фотонным кристаллам; уметь писать макросы для самостоятельно разработанных программных продуктов; Должен владеть навыками анализа научно-технической литературы, навыками расчета электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов; методами решения уравнений в частных производных для теоретических и практических задач с использованием информационных, компьютерных технологий; владеть стандартными пакетами автоматизированного проектирования;

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций на всех этапах приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенций по этапам

Показатели и критерии	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости	Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем	Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы
Хорошо (базовый уровень)	Знает факты, принципы, процессы, общие понятия	Обладает диапазоном практических умений,	Берет ответственность за завершение задач в ис-

	тия в пределах изучаемой области	требуемых для решения определенных проблем в области исследования	следовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем
Удовлетворительно (пороговый уровень)	Обладает базовыми общими знаниями	Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач	Работает при прямом наблюдении

## 2 Реализация компетенций

### 2.1 Компетенция ПК-2

ПК-2: готовностью к математическому моделированию процессов и объектов фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	методы обработки и анализа информации в уравнениях с частными производными применительно к фотонным кристаллам; знать методы математического анализа поставленной задачи исследований в фотонных кристаллах	моделировать реальные процессы как краевые задачи для уравнений в частных производных применительно к фотонным кристаллам; уметь писать макросы для самостоятельно разработанных программных продуктов	методами решения уравнений в частных производных для теоретических и практических задач с использованием информационных, компьютерных технологий; владеть стандартными пакетами автоматизированного проектирования
Виды занятий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивные практические занятия;</li> <li>• Интерактивные лекции;</li> <li>• Практические занятия;</li> <li>• Лекции;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивные практические занятия;</li> <li>• Интерактивные лекции;</li> <li>• Практические занятия;</li> <li>• Лекции;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивные практические занятия;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> </ul>
Используемые средства оценивания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опрос на занятиях;</li> <li>• Выступление (доклад) на занятии;</li> <li>• Конспект самоподготовки;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опрос на занятиях;</li> <li>• Выступление (доклад) на занятии;</li> <li>• Конспект самоподготовки;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выступление (доклад) на занятии;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• знать методы математического анализа;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уметь моделировать реальные процессы;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• свободно и творчески решать задачи;</li> </ul>

	<p>тического моделирования, обработки и анализа информации в уравнениях с частными производными при описании процессов, происходящих в фотонных кристаллах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• знать методы математического анализа поставленной задачи исследований в фотонных кристаллах;</li> </ul>	<p>различные процессы в фотонных кристаллах как краевые задачи для уравнений в частных производных;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• уметь писать макросы и осуществлять взаимосвязь файлов для самостоятельно разработанных программных продуктов;</li> </ul>	<p>решать уравнения в частных производных для теоретических и практических задач с широким использованием стандартных и продвинутых компьютерных технологий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свободно и уверенно владеть стандартными и продвинутыми программными пакетами автоматизированного проектирования;</li> </ul>
Хорошо (базовый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• знать методы обработки и анализа информации в уравнениях с частными производными при описании процессов, происходящих в фотонных кристаллах;</li> <li>• знать методы математического анализа поставленной задачи исследований в фотонных кристаллах;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уметь моделировать типовые процессы в фотонных кристаллах, представленные как краевые задачи для уравнений в частных производных;</li> <li>• уметь писать макросы для самостоятельно разработанных программных продуктов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• владеть методами решения уравнений в частных производных для теоретических и практических задач с использованием стандартных компьютерных технологий;</li> <li>• уверенно владеть стандартными пакетами автоматизированного проектирования;</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• знать методы обработки и анализа информации в уравнениях с частными производными;</li> <li>• знать методы математического анализа поставленной задачи исследований при описании процессов, происходящих в фотонных кристаллах;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уметь моделировать реальные процессы в фотонных кристаллах, представленные как краевые задачи для уравнений в частных производных;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• под наблюдением владеть методами решения уравнений в частных производных для практических задач с использованием компьютерных технологий;</li> <li>• владеть стандартными пакетами автоматизированного проектирования;</li> </ul>

## 2.2 Компетенция ПК-3

ПК-3: способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Этапы формирования компетенции и используемые средства оценивания

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Содержание этапов	фундаментальные физические закономерности, определяющие свойства кристаллических и некристаллических материалов	выполнять оценочные расчеты электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов	навыками анализа научно-технической литературы, навыками расчета электрических, механических и тепловых характеристик фотонных



			кристаллов
Виды занятий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивные практические занятия;</li> <li>• Интерактивные лекции;</li> <li>• Практические занятия;</li> <li>• Лекции;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивные практические занятия;</li> <li>• Интерактивные лекции;</li> <li>• Практические занятия;</li> <li>• Лекции;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивные практические занятия;</li> <li>• Самостоятельная работа;</li> </ul>
Используемые средства оценивания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опрос на занятиях;</li> <li>• Конспект самоподготовки;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опрос на занятиях;</li> <li>• Конспект самоподготовки;</li> <li>• Зачет;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зачет;</li> </ul>

Формулировка показателей и критериев оценивания данной компетенции приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

Состав	Знать	Уметь	Владеть
Отлично (высокий уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает фактическими и теоретическими знаниями о фундаментальных физических закономерностях, определяющих свойства кристаллических и некристаллических материалов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• строить математические и физические модели для выполнения оценочных расчетов электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов с последующим применением этих моделей для разработки и исследований устройств фотоники;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками анализа научно-технической литературы о фотонных кристаллах с последующим применением этой информации для разработки и исследований устройств фотоники;</li> <li>• современными подходами и методиками построения математических и физических моделей процессов, происходящих в фотонных кристаллах с последующим применением этих моделей для разработки и исследований устройств фотоники;</li> <li>• навыками расчета электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов;</li> </ul>
Хорошо (базовый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Знает принципы, процессы, общие понятия о кристаллических и некристаллических материалах;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• строить математические и физические модели для выполнения расчетов электрических характеристик фотонных кристаллов с последующим применением этих моделей для</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками анализа научно-технической литературы о фотонных кристаллах с последующим применением этой информации для разработки и исследований устройств фотоники;</li> </ul>

		разработки и исследований устройств фотоники;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками расчета электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов;</li> </ul>
Удовлетворительно (пороговый уровень)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладает базовыми общими знаниями о фундаментальных физических закономерностях, определяющих свойства кристаллических и некристаллических материалов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• строить математические и физические модели для выполнения расчетов электрических характеристик фотонных кристаллов;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• навыками расчета электрических, механических и тепловых характеристик фотонных кристаллов;</li> </ul>

### 3 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в следующем составе.

#### 3.1 Вопросы на самоподготовку

– Задача о трехмерной дифракции в фотонных кристаллах. Оптические и магнитооптические эффекты в фотонных кристаллах. Солитонное и волноводное распространение света в фотонных кристаллах с квадратичной и кубичной восприимчивостями. Нелинейно-оптические и нелинейные магнитооптические эффекты в фотонных кристаллах. Эффекты на кубичной восприимчивости. Суперконтинуум и бистабильность в фотонных кристаллах. Методы создания оптических сверхрешетках и нелинейных фотонных кристаллов. Методы создания нелинейных фотонных кристаллов. Спиновые (магнитные) кристаллы. Плазмонные кристаллы.

#### 3.2 Темы опросов на занятиях

– Методы расчета фотонной запрещенной зоны одномерных, двумерных и трехмерных фотонных кристаллов. Методы описания нелинейно-оптического отклика фотонных кристаллов и нелинейного распространения света в фотонных решетках. Нелинейные фотонные кристаллы и оптические сверхрешетки. Понятие о нелинейных фотонных кристаллах. Двумерный фазовый синхронизм при генерации второй гармоники в нелинейных фотонных кристаллах. Основные материалы для изготовления фотонных кристаллов. Примеры одномерных фотонных кристаллов. Брэгговские зеркала, микрорезонаторы, одномерные волноводы. Двумерные фотонные кристаллы. Трехмерные фотонные кристаллы. Периодические и квазипериодические доменные структуры. Методы создания нелинейных фотонных кристаллов. Устройства оптоэлектроники на основе фотонных кристаллов. Магнитооптические модуляторы света.

#### 3.3 Темы докладов

– Методы расчета фотонной запрещенной зоны двумерных фотонных кристаллов. Солитонное и волноводное распространение света в фотонных кристаллах с квадратичной и кубичной восприимчивостями. Нелинейные фотонные кристаллы и оптические сверхрешетки. Нелинейно-оптические и нелинейные магнитооптические эффекты в фотонных кристаллах. Эффекты на кубичной восприимчивости. Суперконтинуум и бистабильность в фотонных кристаллах. Дырчатые волокна. Микролазеры без инверсии населенности. Оптические переключатели и мультиплексоры. Магнитооптические модуляторы света. Электромагнитные кристаллы для ИК и СВЧ областей.

#### 3.4 Зачёт

– Методы описания зонной структуры фотонных кристаллов. Методы расчета фотонной запрещенной зоны одномерных, двумерных и трехмерных фотонных кристаллов. Методы описания нелинейно-оптического отклика фотонных кристаллов и нелинейного распространения света в фотонных решетках. Нелинейные фотонные кристаллы и оптические сверхрешетки. Понятие о не-

линейных фотонных кристаллах. Брэгговские зеркала, микрорезонаторы, одномерные волноводы. Двумерные фотонные кристаллы. Трехмерные фотонные кристаллы. Методы создания нелинейных фотонных кристаллов. Устройства оптоэлектроники на основе фотонных кристаллов. Оптические диоды и транзисторы.

#### **4 Методические материалы**

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, согласно п. 12 рабочей программы.

##### **4.1. Основная литература**

1. Шандаров С.М., Шандаров В.М., Мандель А.Е., Буримов Н.И. Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах. - Томск:ТУСУР, 2007. – 241 с. ISBN 978-5-86889-426-8. (наличие в библиотеке ТУСУР - 64 экз.)

##### **4.2. Дополнительная литература**

1. Байков Ю.А., Кузнецов В.М. Физика конденсированного состояния - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 294 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 45 экз.)

2. Петров М.П., Степанов С.И., Хоменко А.В. // Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике. - СПб.: Наука, 1992. - 320 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)

3. Гуртов В.А. Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие /В. А. Гуртов, Р. Н. Осауленко. - М. : Техносфера, 2007. – 518 с. - ISBN 978-5-94836-141-3 (наличие в библиотеке ТУСУР - 1 экз.)

##### **4.3. Обязательные учебно-методические пособия**

1. Физика фотонных кристаллов: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов направления "Фотоника и оптоинформатика" / Щербина В. В., Шандаров С. М. - 2014. 18 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/4090>, свободный.

2. Физика фотонных кристаллов : Методические указания по самостоятельной работе / Щербина В. В., Шандаров С. М. - 2012. 14 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/1107>, свободный.

##### **4.4. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы**

1. Образовательный портал университета, библиотека университета